

第 15 章 电磁场与电磁波

一 求位移电流

1. 位移电流的定义

· 为了使安培环路定理在非稳恒的情况下普遍适用, 引入位移电流, 将电流的类别扩大

· 位移电流密度 $\mathbf{j}_d = \frac{d\mathbf{D}}{dt}$ · 位移电流 $I_d = \frac{d\Phi_D}{dt}$ (方向规定为 \mathbf{D} 增量的方向)

如何求位移电流

· 通过第 10 章的知识, 由 U 、 \mathbf{E} 等参数求出 D , 再通过定义式求出 \mathbf{j}_d , 进而求出 I_d

例 1 一平板电容器两极板面积为 S , 极板间距为 d , 两极板与一电压 $V = V_0 \sin \omega t$ 的交流电源连接, 则穿过电容器的位移电流密度为 _____, 位移电流的大小为 _____.

解 由定义式: $\mathbf{j}_d = \frac{d\mathbf{D}}{dt} = \epsilon_0 \frac{d\mathbf{E}}{dt} = \frac{\epsilon_0}{d} \frac{dV}{dt} = \frac{\epsilon_0 \omega V_0}{d} \cos \omega t$ $I_d = \mathbf{j}_d S = \frac{\epsilon_0 \omega V_0}{d} \cos \omega t$

二 麦克斯韦方程组

$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \int_V \rho dV = \sum q$	($\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$
$\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d\Phi_m}{dt} = -\int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}$	($\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$
$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$	(1	$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$
$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \sum I + \frac{d\Phi_D}{dt} = \int_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S} + \int_S \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}$		$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$

三 电磁波

1. 电磁波的性质

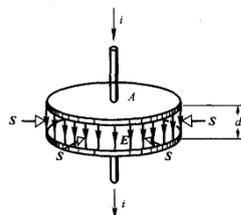
电磁波是横波, 传播的是电场 \mathbf{E} 和磁场 \mathbf{H} , 两者垂直, 传播方向恒为 $\mathbf{E} \times \mathbf{H}$, 速度为光速 $c = 1 / \sqrt{\mu_0 \epsilon_0}$

2. 能流密度与 \mathbf{S}

· \mathbf{S} : 电磁波的能流密度 (单位时间通过垂直于传播方向的单位面积的能量)

· 矢量形式: $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$ (坡印亭矢量)

例 2 图中表示一正在充电的平行板电容器。电容器圆形极板的半径为 R , 极板间距离为 d 。试计算电容器界面处的能流密度, 并通过能流密度计算单位时间内进入电容器内部的总能量。



解 由全电流的安培环路定理, 半径 R 处的磁场强度 $H = \frac{\pi R^2 j_d}{2\pi R} = \frac{\epsilon_0 R}{2} \frac{dE}{dt}$, 俯视顺时针

则能流密度 $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} = \frac{\epsilon_0 R E}{2} \frac{dE}{dt}$ (方向指向轴线), 能量 $A = 2\pi R d S = \pi R^2 d \epsilon_0 E \frac{dE}{dt}$